



王圩



王圩，男，中科院院士，研究员，博士生导师。

1960年毕业于北京大学物理系，1988年被授予“国家有突出贡献中青年专家”称号，1997年当选为中科院院士。

近十年来在应变量子阱激光器、电吸收调制器及其集成以及半导体光放大器等方面取得的主要成绩：在国内首先研制成功应变量子阱1.55微米DFB激光器；随后，指导研究生采用周期埋岛结构，实现了新型反相位增益耦合量子阱DFB激光器、采用SAG技术，研制成功2.5Gb/s EA-MD/DFB-LD 单片集成模块，并成功地在400公里标准光纤上进行了2.5Gb/s码率的传输、采用应变渐变结构研制成功偏振不灵敏的宽带1550nm波段半导体光放大器以及电吸收调制器和模斑转换器单片集成器件等。所负责的研究项目获国家科技进步二等奖两次；中国科学院科技进步一等奖一次、二等奖两次。

目前的研究领域：

InP基半导体光电子集成器件的研究。

联系方式：

E-mail : wwang@semi.ac.cn

负责的科研项目：

- 1.国家“973”项目：“新型量子阱功能材料和器件”（2001-2005）
- 2.国家自然科学基金重大项目：“光网络用光放大器、电吸收调制器和模斑转换器串接集成材料与器件的研究”（2002-2004）

代表性论著：

1. W.Qiu, W.Qiu, W.Wang, J.Dong, J.Dong, F.Zho, J.Y.Zhang, H.L.Zhu, and L.J.Zhao, “Selective-area MOCVD growth for distributed feedback lasers integrated with vertically tapered self-aligned waveguide” *J. Crystal Growth, Vol.250, No.3-4, pp583-587, 2003*
2. Y.Lu, W.Wang, H.L.Zhu, F.Zhou, B.J.Wang, J.Y.Zhang, L.J.Zhao,

“ Tunable DBR Laser Fabricated by Bundle Integrated Guide” (in English) , Chinese Journal of Semiconductor *Vol.24, No.2, PP113-116, 2003*

3. W. Qui, W.Wang, J. Dong, J.Y. Zhang, H.L.Zhu, F.Zhou, “ Spotsize Converter Integrated DFB Laser Diode Using Selective Area Growth MOCVD” (in English) , Chinese Journal of Semiconductor , *Vol.23, No.5, pp459-463, May 2002*

4. W.Wang, R.Y.Zhang, J.Dong, Z.W.Feng, F.Zhou “Polarization-insensitive semiconductor optical amplifier with graded tensile bulk-like active structure” OECC2002 (invited paper) *2002.7, Japan.*

5. G..L.Liu, W.Wang, H.L.Zhu, J.Y.Zhang, X.H.Hu, Y.Lu, J.Zhang, “Self-aligned Coupled Wave guide DBR Lasers” (in English) , Chinese J. Lasers, *Vol.B11, No.2, pp87-90, 2002*

6. Y.Sun, W.Wang, W.X.Chen, G.L.Liu, F.Zhou, H.L.Zhu, “High Extinction Ratio Polarization Independent EA-Modulator” (in English), Chinese J. Semiconductors, *Vol.22, No.11, pp1374-1376, 2001*

7. W.Wang, G.L.Liu, H.L.Zhu, J.Y.Zhang, “High Speed DFB Laser and EMLs” Proc. SPIE, *Vol.4850, pp26-34, 2001*

8. B.Chen, W.Wang, X.J.Wang, J.Y.Zhang, F.Zhou, “A Novel 1.3- μm High T_0 AlGaInAs/InP Strained Multi-Quantum Well Complex-Coupled DFB Laser Diode” Jpn J.Appl.Phys. *Vol.38, pp5096-5100, 1999*

9. W.Wang, J.Y.Zhang, H.L.Tian, Y.B.Miao, X.J.Wang, C.H.Ma, L.M.Wang, H.Lu, J.H.Gao, H.H.Gao, “1.5 μm InGaAsP/InP RW-DFB Laser” International J. Optoelectronics, *Vol.7, No.1, pp63-69, 1992*

10. W.Wang, M.T.Pang, K.Komori, K.S.Lee, S.Arai, Y.Suematsu, “A Modified 1.5 μm GaInAsP/InP BIG-DBR Laser with an Inner Island Substrate” , Jpn J.Appl.Phys., *Vol.27, No.7, pp L1313-L1316, 1988*

半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地，国家于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所开启了我国半导体科学技术的发展之路。

北京市海淀区清华东路甲35号 北京912信箱 (100083)

电话

010-82304210/010-82305052(传真)

E-mail

semi@semi.ac.cn

交通地图

友情 链接

[中华人民共和国科学技术部](#)

[中国科学院](#)